

# Technische Information / Technical Information

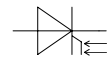
**eupec**

Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

**T 1503 N 75...80 TOH**

**N**



## Features:

### Lichtgezündeter Netz Thyristor mit integriertem Überspannungsschutz

Volle Sperrfähigkeit bei 120° mit 50 Hz

Hohe Stoßströme und niedrige Wärme-  
widerstände durch NTV-Verbindung  
zwischen Silizium und Mo-Trägerscheibe.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H

### Phase Control Thyristor, light triggered with integrated overvoltage protection

Full blocking capability at 120°C with 50 Hz

High surge currents and low thermal resistance  
by using low temperature-connection NTV  
between silicon wafer and molybdenum.

Electroactive passivation by a - C:H

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak reverse voltage	f = 50 Hz	$V_{RRM}$	$T_{vj \min} = -40^{\circ}\text{C}$ 7500 8000	$T_{vj \min} = 0^{\circ}\text{C}$ 7700 8200	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		$I_{TRMSM}$		3800	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$ $T_C = 60^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$	$I_{TAVM}$		1760 2440	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{TSM}$		45 40	kA kA
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$		$10,1 \cdot 10^6$ $8,0 \cdot 10^6$	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit, periodisch critical rate of rise of on-state current, repetitive	DIN IEC 747-6 $V_D \leq V_{BO}, f = 50\text{Hz},$ $P_L = 40\text{mW}, t_{rise} = 0,5\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$		300	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Stromsteilheit, nicht-periodisch critical rate of rise of on-state current, non-repetitive	DIN IEC 747-6 $V_D \leq V_{BO}, P_L = 40\text{mW}, t_{rise} = 0,5\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$		1000	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of forward voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_{DM} = 5\text{kV}$	$(dv/dt)_{cr}$		2000	V/ $\mu\text{s}$

www.DataSheet4U.com

# Technische Information / Technical Information

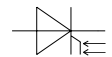
**eupec**

Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

## T 1503 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

**N**



### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

Schutzzündspannung (statisch) protective break over voltage	$T_{vj} = 0^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{BO}$	min. 7500	V
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, I_T = 4\text{kA}$	$V_T$	typ. 2,8 max. 3,0	V
Schleusenspannung / threshold voltage Ersatzwiderstand / slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{TO}$ $\Gamma_T$	typ. 1,20 max. 1,24 0,40 0,44	V m $\Omega$
Durchlaßrechenkennlinie on-state characteristics for calculations $V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$ 500 A $\leq i_T \leq$ 5000 A	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	A B C D	typ. 0,616 max. -0,0864 0,000219 0,000343 0,0342 0,2021 0,0161 0,000614	
erforderliche Zündlichtleistung required gate trigger light power	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 100\text{V}$	$P_{LM}$	min. 40	mW
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_H$	350	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 100\text{V},$ $P_L = 40\text{mW}, t_{\text{an}} = 0,5\mu\text{s}$	$I_L$	1	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_D = v_R = 7500\text{V}$	$i_D, i_R$	500	mA
Zündverzug gate controlled delay time	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 1000\text{V},$ $P_L = 40\text{mW}, t_{\text{an}} = 0,5\mu\text{s}$	$t_{gd}$	typ. 5	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{V}, v_{DM} = 0,67 \cdot v_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 4. Kennbuchstabe / 4 <sup>th</sup> letter O	$t_q$	typ. 550	$\mu\text{s}$
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $I_{TM} = 2,5\text{ kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$	$Q_r$	15	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $I_{TM} = 2,5\text{ kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$	$I_{RM}$	350	A

# Technische Information / Technical Information

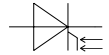
**eupec**

Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

**T 1503 N 75...80 TOH**

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

**N**



## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ \sin$	$R_{thJC}$	0,0063	$^\circ\text{C/W}$
	beidseitig / two-sided, DC		0,0060	$^\circ\text{C/W}$
	Anode / anode DC		0,0106	$^\circ\text{C/W}$
	Kathode / cathode DC		0,0138	$^\circ\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	beidseitig / two-sided	$R_{thCK}$	0,0015	$^\circ\text{C/W}$
	einseitig / single-sided		0,003	$^\circ\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$	+120	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	-40...+120	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40...+150	$^\circ\text{C}$

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 4	
Si-Element mit Druckkontakt, Lichtzündung Si-pellet with pressure contact, light triggered	Silizium Tablette silicon wafer		101LTN80	
Anpreßkraft clamp force		F	63...91	kN
Gewicht weight		G	typ. 3200	g
Kriechstrecke creepage distance			49	mm
Feuchteklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	$\text{m/s}^2$

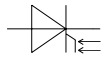
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.  
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

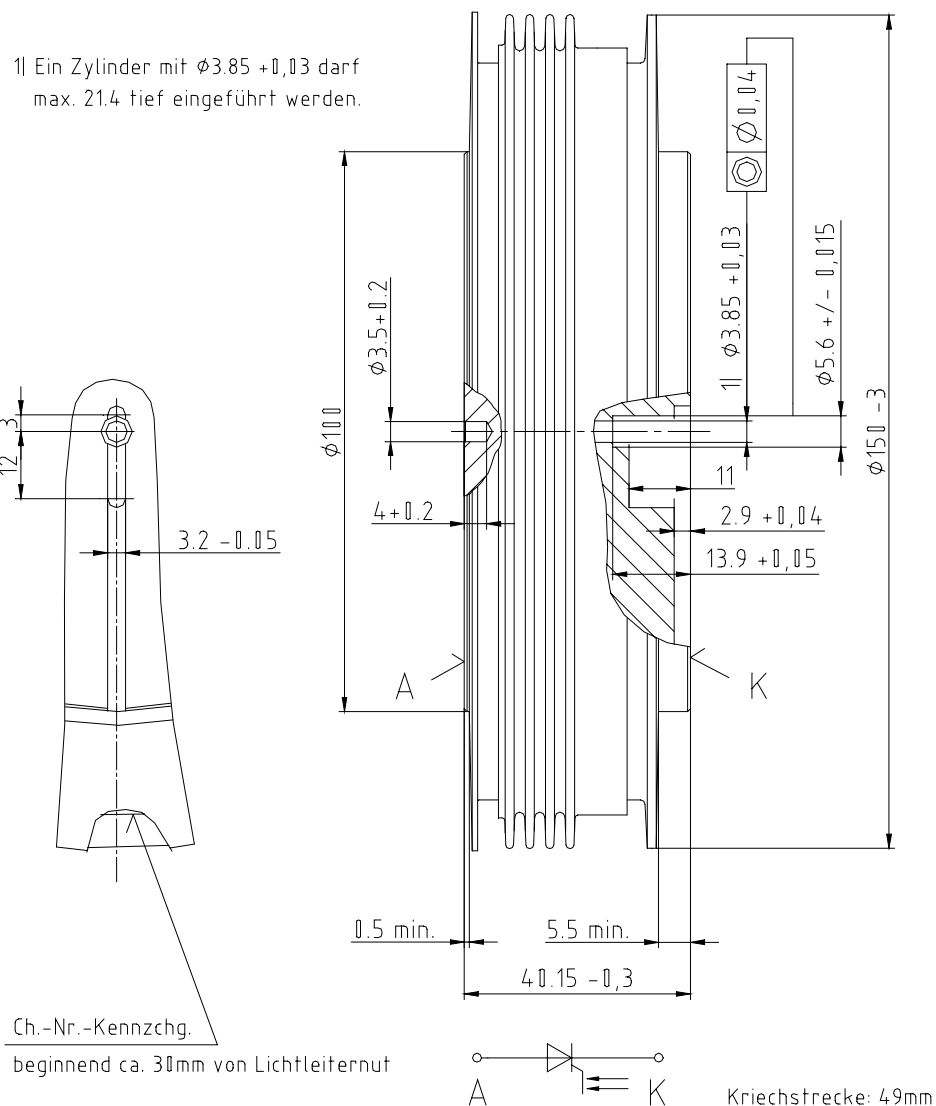
T 1503 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

N



Maßbild / Outline

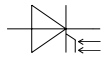


Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

T 1503 N 75...80 TOH

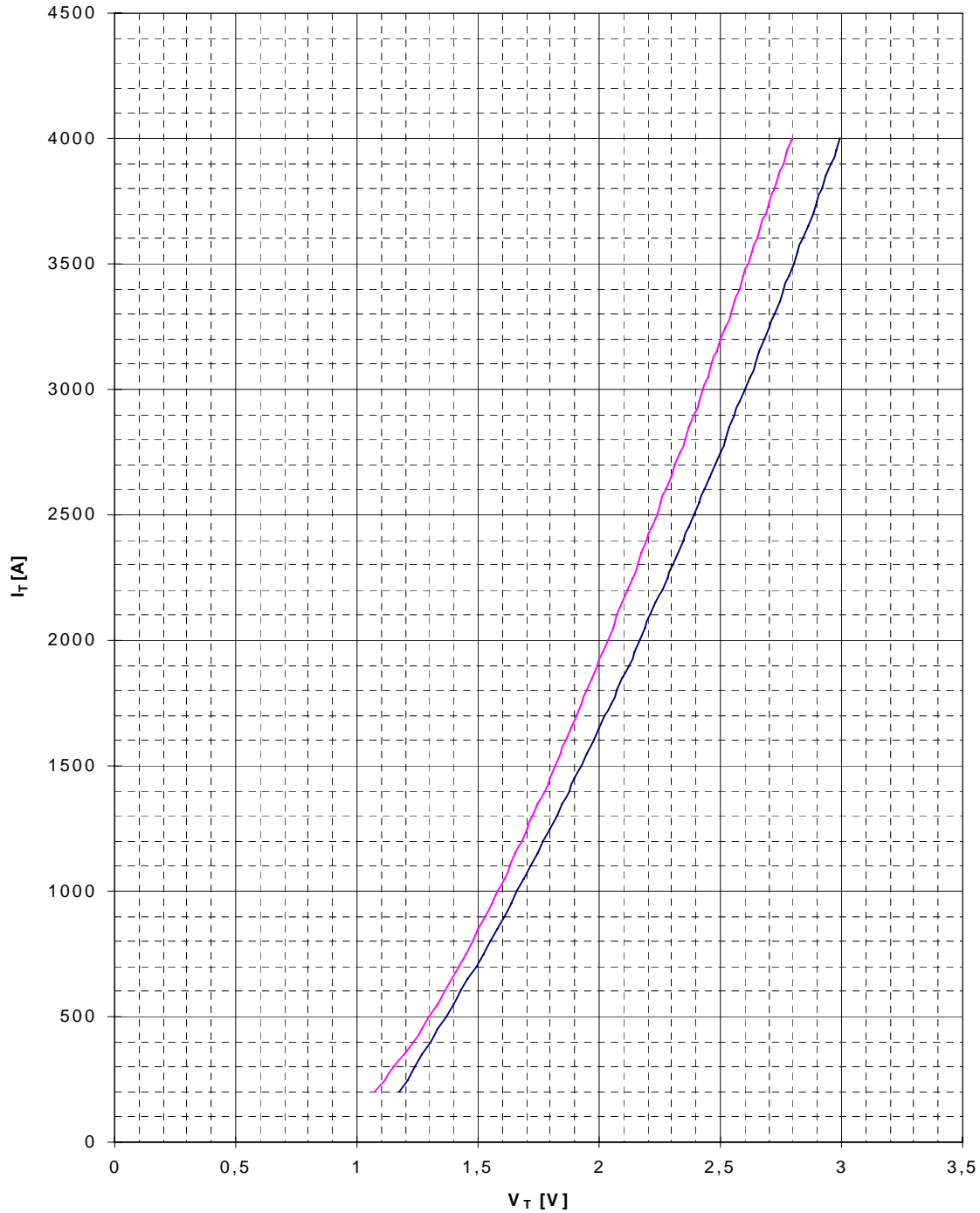
Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

N



**Durchlaßkennlinien  $i_T = f(v_T)$**   
Limiting and typical on-state characteristic

$T_{vj} = 120^\circ\text{C}$

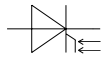


Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

T 1503 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

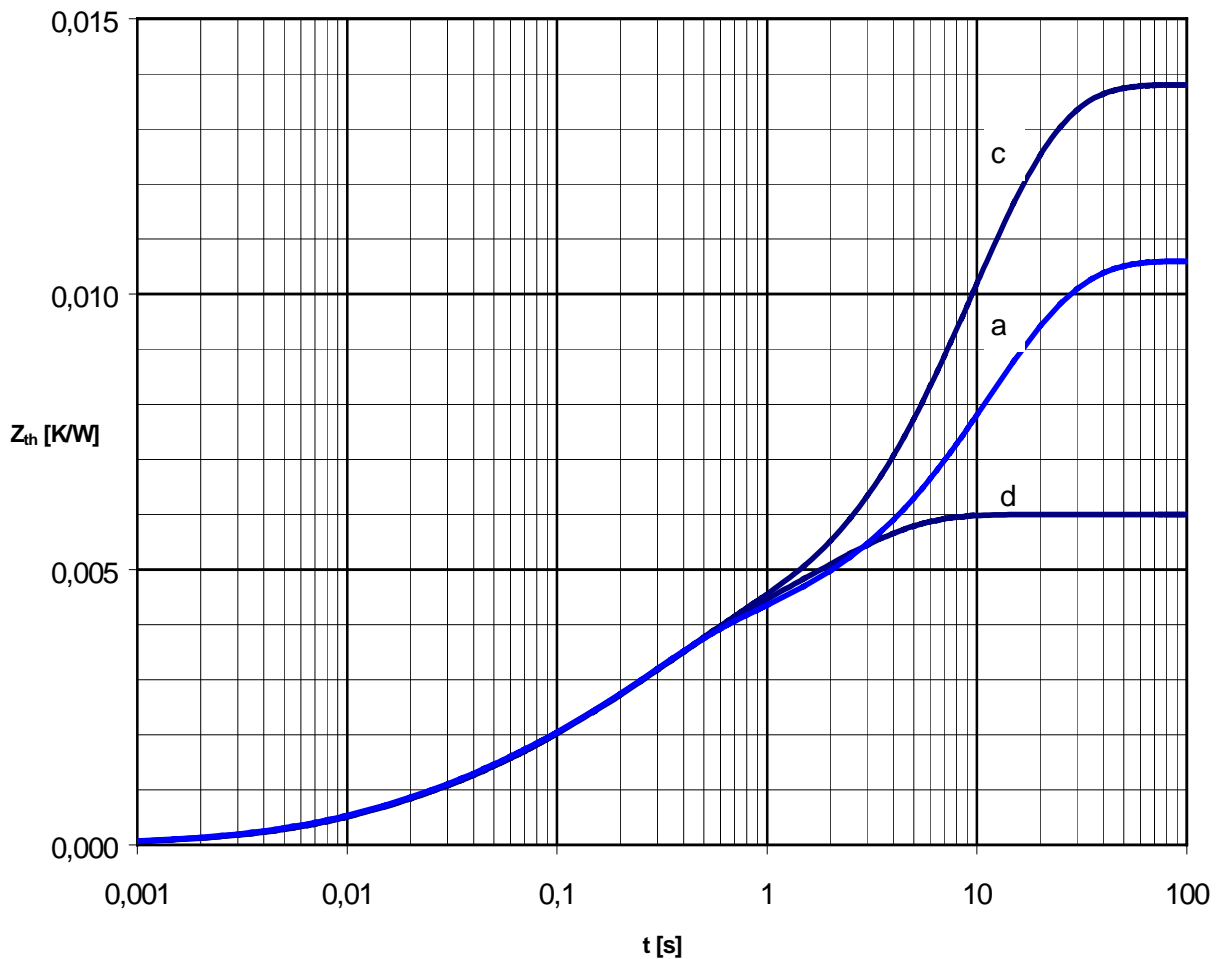
N



**Transienter innerer Wärmewiderstand  
Transient thermal impedance  $Z_{th\ JC} = f(t)$**

$$Z_{th\ JC}(t) = R_{th\ n} \cdot (1 - e^{-t/\tau_n})$$

n	beidseitige Kühlung / double sided cooling		kathodenseitige Kühlung / cathod sided cooling		anodenseitige Kühlung / anode sided cooling	
	$R_{th\ n}$ [K/W]	$\tau_n$ [s]	$R_{th\ n}$ [K/W]	$\tau_n$ [s]	$R_{th\ n}$ [K/W]	$\tau_n$ [s]
1	0,00238	2,06	0,0102	9,62	0,00662	11,6
2	0,00202	0,301	0,00224	0,268	0,00043	0,946
3	0,00110	0,0674	0,00092	0,0532	0,00248	0,219
4	0,0005	0,0122	0,00044	0,0107	0,00081	0,0310
5	0	1	0	1	0,00026	0,00761
$\Sigma$	<b>0,006</b>	-	<b>0,0138</b>	-	<b>0,0106</b>	-

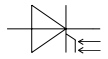


Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

T 1503 N 75...80 TOH

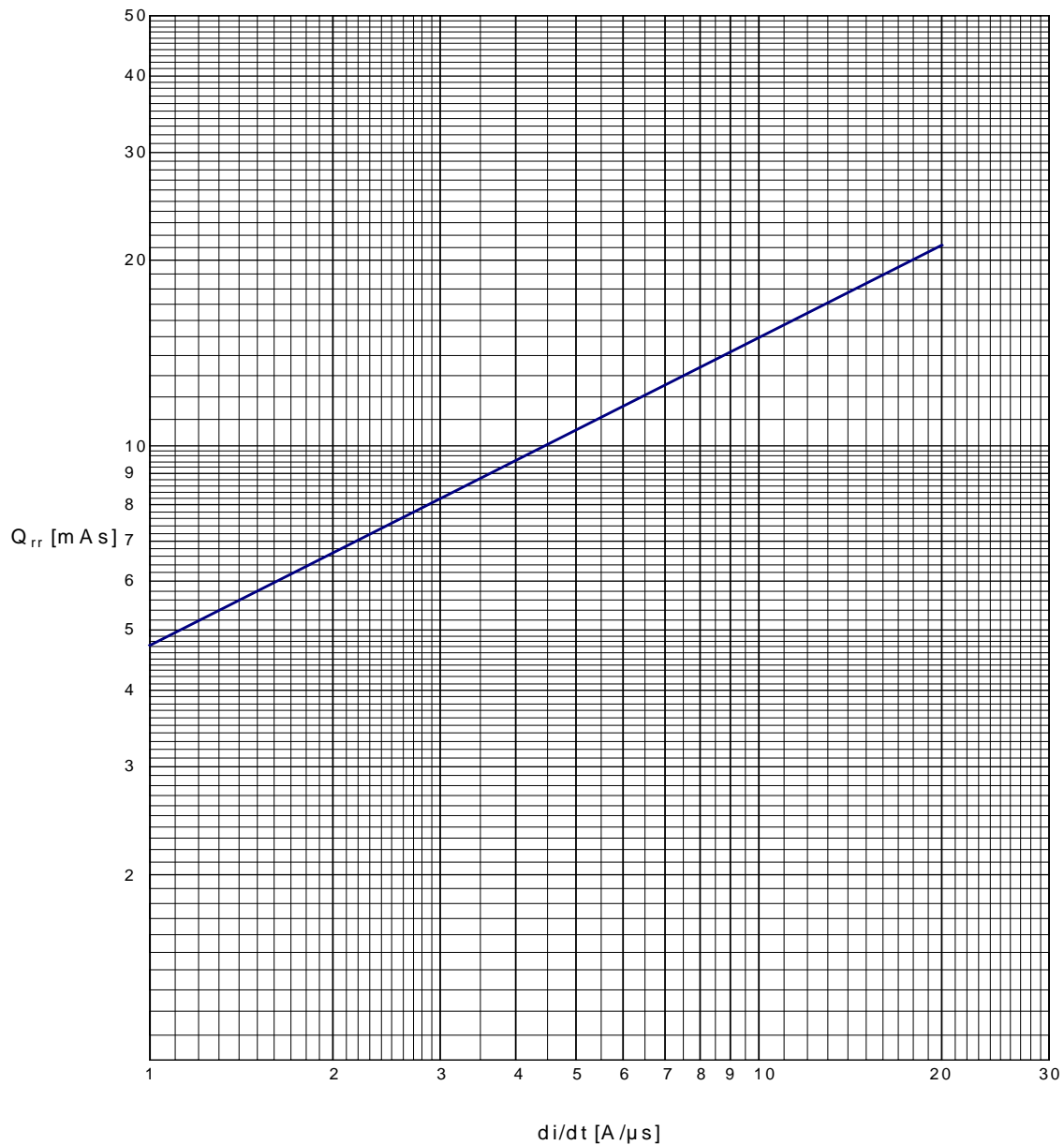
Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

N



**Sperrverzögerungsladung  $Q_r = f(-di/dt)$**   
recovered charge

Nebenbedingungen:  $T_{vj} = 120^\circ\text{C}$ ,  $I_{TM} = 4000\text{A}$ ,  $v_R = 0,5 \cdot V_{RRM}$ ,  $v_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$

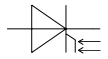


Lichtgezündeter Netz Thyristor  
mit integriertem Überspannungsschutz

T 1503 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered  
with integrated overvoltage protection

N



**Rückstromspitze / reverse recovery current**  
(typische Abhängigkeit / typical dependence)

$$I_{RM} = f (di/dt)$$

$T_{vj} = 120^{\circ}C, I_{TM} = 2500A, v_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$

